

製品概要

NIS5112: 12 V電子ヒューズ、eFuse

技術情報は、データシートをご参照ください。



NIS5112は、内部チャージ・ポンプで駆動されるハイ・サイドNチャンネルFETを活用する統合スイッチです。このスイッチの特長は、電流センシングで高価な低インピーダンスの電流シャントではなく安価なチップ抵抗器の使用を許容するMOSFETです。12 Vシステムで動作するように設計され、頑強なサーマル保護回路があります。

特長

- Integrated Power Device
- Power Device Thermally Protected
- No External Current Shunt Required
- Enable/Timer Pin
- Adjustable Slew Rate for Output Voltage
- 9 V to 18 V Input Range
- 30 mΩ Typical
- Internal Charge Pump

アプリケーション

- Hard Drives

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

4/12/2021 作成